

## DUAL ULTRAFAST POWER RECTIFIER

Qualified per MIL-PRF-19500/642

### DEVICES

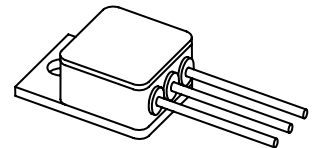
<b>1N6762</b>	<b>1N6764</b>	<b>1N6762R</b>	<b>1N6764R</b>
<b>1N6763</b>	<b>1N6765</b>	<b>1N6763R</b>	<b>1N6765R</b>

### LEVELS

<b>JAN</b>
<b>JANTX</b>
<b>JANTXV</b>

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RWM}$	50	Vdc
1N6762, R		100	
1N6763, R		150	
1N6764, R		200	
Average Forward Current <sup>(1)</sup>	$I_F$	12	Adc
$T_C = +100^\circ\text{C}$			
Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	165	A(pk)
Thermal Resistance - Junction to Case	$R_{\theta jc}$	2.0	$^\circ\text{C/W}$



TO-254

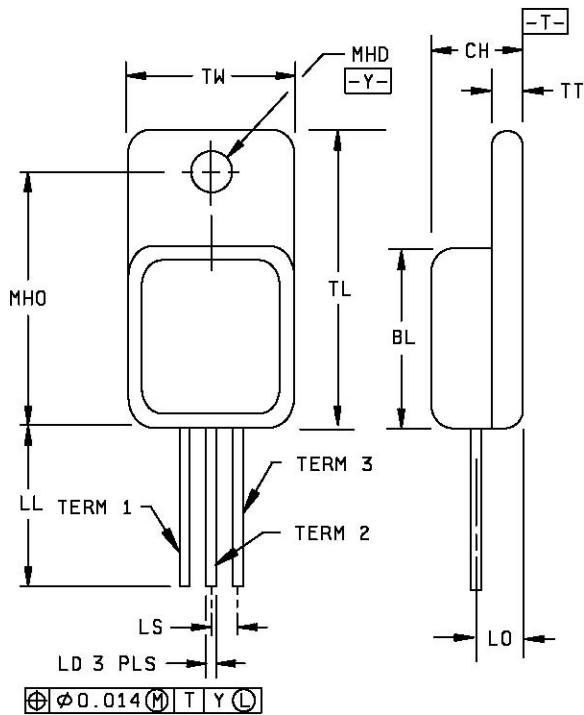
### Note:

- (1) Derate @ 240mA/ $^\circ\text{C}$  above  $T_C = 100^\circ\text{C}$
- (2) Each individual diode

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Breakdown Voltage <sup>(2)</sup>	$V_{BR}$	50		Vdc
1N6762, R		100		
1N6763, R		150		
1N6764, R		200		
Forward Voltage <sup>(2)</sup>	$V_{F1}$		0.95	Vdc
$I_F = 6\text{A dc}$			1.05	
Reverse Leakage Current	$I_{R1}$		10	$\mu\text{A dc}$
$V_R = 50\text{V}$				
1N6762, R				
1N6763, R				
Reverse Leakage Current	$I_{R2}$		500	$\mu\text{A dc}$
$V_R = 100\text{V}$				
1N6764, R				
1N6765, R				
Reverse Recovery Time	$t_{rr}$		35	nS
$I_F = 1.0\text{A}$ , $di/dt = 50\text{A}/\mu\text{s}$				
Junction Capacitance	$C_J$		300	pF
$V_R = 5\text{V dc}$ , $f = 1.0\text{MHz}$				

## PACKAGE DIMENSIONS



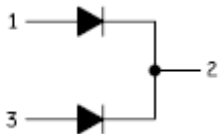
Symbol	Dimensions			
	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
BL	.535	.545	13.59	13.84
CH	.249	.260	6.32	6.60
LD	.035	.045	0.89	1.14
LL	.510	.570	12.95	14.48
LO	.150 typ		3.81 typ	
LS	.150 bsc		3.81 bsc	
MHD	.139	.149	3.53	3.78
MHO	.665	.685	16.89	17.40
TL	.790	.800	20.07	20.32
TT	.040	.050	1.02	1.27
TW	.535	.545	13.59	13.84

### NOTES:

- 1 Dimensions are in inches.
- 2 Millimeters are given for general information only.
- 3 All terminals are isolated from case.
- 4 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to  $\phi$ x symbology.

### SCHEMATIC

1N6762, 1N6763, 1N6764, 1N6765

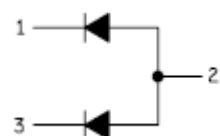


Terminal

Description

1	Anode 1
2	Cathode
3	Anode 2

1N6762R, 1N6763R, 1N6764R, 1N6765R



Terminal

Description

1	Cathode 1
2	Anode
3	Cathode 2

**FIGURE 1: Physical dimensions and configuration (TO-254AA, isolated)**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9